

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญภาพ	ญ
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความสำคัญและที่มาของงานวิจัย	1
1.2 ผลการศึกษาผลของชั้นต่อต้านการสะท้อนแสงต่อประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์	3
1.3 วัตถุประสงค์	6
1.4 ขอบเขตการศึกษา	6
บทที่ 2 ทฤษฎี	
2.1 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง (Dye Sensitized Solar Cells)	7
2.1.1 การวัดประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อม (DSSC)	10
2.1.2 การวัดค่าความต้านทานของเซลล์แสงอาทิตย์	12
2.2 ชั้นต่อต้านการสะท้อนแสง (Anti-reflection layer)	16
2.3 เทคนิคการเตรียมฟิล์มบางซิงก์ออกไซด์	24
2.3.1 การระเหยสารด้วยความร้อนในระบบสุญญากาศ (Thermal evaporation in vacuum)	24
2.3.2 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนด้วยวิธีการสปาร์ค (Synthesis of Nanoparticle by Sparking process)	25
2.4 สมบัติของซิงก์ออกไซด์ (ZnO)	26
2.5 อัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรสโกปี (UV-vis spectroscopy)	27
2.5.1 ส่วนประกอบของ Spectrophotometer	29

	หน้า
2.5.1.1 แหล่งกำเนิดรังสี (Source)	29
2.5.1.2 โมโนโครมิเตอร์ (Monochrometer)	30
2.5.1.3 อุปกรณ์บันทึกสัญญาณ (Recorder)	30
2.5.1.4 เซลล์บรรจุสารตัวอย่าง	30
2.5.2 ประเภทของ UV-visible spectrophotometer	31
2.5.2.1 Single-beam spectrophotometer	31
2.5.2.2 Double-beam spectrophotometer	32
2.6 อีลิปโซเมทรี (Ellipsometry)	33
2.6.1 หลักการหาค่าดัชนีหักเหของแสงและความหนาของฟิล์มบาง	34
2.7 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM)	38
2.7.1 โครงสร้างของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด	38
2.7.2 หลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด	39
2.8 ค่ามวลอากาศ (Air mass)	40
บทที่ 3 วัสดุ อุปกรณ์การทดลองและวิธีการทดลอง	
3.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการทดลอง	44
3.1.1 สารเคมี	44
3.1.2 อุปกรณ์	50
3.2 การทดลอง	57
3.2.1 การเตรียมฟิล์มบางซิงก์ออกไซด์	57
3.2.1.1 การเตรียมฟิล์มบางซิงก์ออกไซด์ด้วยกระบวนการระเหยสารด้วยความร้อน (thermal evaporation)	57
3.2.1.2 การเตรียมฟิล์มบางซิงก์ออกไซด์ด้วยกระบวนการ sparking process	59
3.2.2 การหาสมบัติของฟิล์มบางซิงก์ออกไซด์	60
3.2.2.1 ความหนาของฟิล์มและดัชนีหักเหของฟิล์มบางซิงก์ออกไซด์	60
3.2.2.2 สมบัติทางแสงของฟิล์มบางซิงก์ออกไซด์	61
3.2.2.3 ลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางซิงก์ออกไซด์	62

	หน้า
3.2.3 การวัดประสิทธิภาพและความต้านทานของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสียอมไวแสง	63
3.2.3.1 ขั้นตอนการเตรียมโฟโตอิเล็กโทโรด	63
3.2.3.2 ขั้นตอนการเตรียมแคโทดรีโออิเล็กโทโรด	65
3.2.3.3 ขั้นตอนการประกอบเซลล์	66
บทที่ 4 ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง	
4.1 ผลการวิเคราะห์หลักคุณสมบัติเฉพาะของฟิล์มบางซิงก์ออกไซด์ (ZnO)	68
4.1.1 ผลการวิเคราะห์ด้วย FE-SEM	68
4.1.2 ผลการวิเคราะห์ด้วย UV-visible spectroscopy	69
4.1.3 ผลการวิเคราะห์ด้วย เครื่อง อิลิปโซเมทรี	75
4.2 ผลการวัดประสิทธิภาพและความต้านทานของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสียอมไวแสง	78
บทที่ 5 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ	
5.1 สรุปผลการทดลอง	83
5.2 ข้อเสนอแนะ	87
บรรณานุกรม	89
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก ผลงานทางวิชาการ	92
ประวัติผู้เขียน	100

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
2.1 แสดงสมบัติทางกายภาพบางประการของ ZnO	26
4.1 ค่าแถบช่องว่างพลังงานสำหรับฟิล์ม ZnO ที่เตรียมได้	71
4.2 ผลการวัดความหนาของฟิล์มบางซิงก์ออกไซด์ด้วยเครื่องอิลิปโซเมทรี ที่ความยาวคลื่น 632.8 nm	78
4.3 เงื่อนไขในการวัดประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีข้อมไวแสงในการทดลองครั้งนี้ที่ความเข้มของการส่องสว่าง 100 mW/cm ²	78
4.4 แสดงค่าวัดทางไฟฟ้าต่างๆ ของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีข้อมไวแสงที่มีฟิล์มบางซิงก์ออกไซด์ที่เป็นชั้นต่อต้านการสะท้อนแสงเทียบกับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีข้อมไวแสงที่ไม่มีชั้นต่อต้านการสะท้อนแสง	80
5.1 ตารางการเปรียบเทียบการทดลองและผลการทดลองของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีข้อมในการศึกษาค้นคว้าอิสระกับงานวิจัยอื่นๆ	86

สารบัญภาพ

รูป	หน้า
1.1 (a) แสดงปริมาณการบริโภคพลังงานที่สูงขึ้น (b) แสดงปริมาณแหล่งพลังงานที่ลดลง	1
2.1 โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง (DSSC)	7
2.2 หลักการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อม	9
2.3 กราฟ I-V (current-voltage curve) ของเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้แสง	10
2.4 วงจรการวัดค่าทางไฟฟ้า (I-V Tester)	11
2.5 แสดงวงจรสมมูลกระแสตรงของเซลล์แสงอาทิตย์	12
2.6 แสดงวิธีการประมาณค่า R_{sh} และ R_s จากกราฟ IV	13
2.7 แสดงวิธีการประมาณค่า R_s จากกราฟ IV ที่ถูกต้อง	14
2.8 แสดงลักษณะทั่วไปของกราฟ IV ของเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้การวัดแบบ reverse bias	15
2.9 โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงที่มีชั้นต่อต้านการสะท้อนแสง	16
2.10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง I_{sc} , V_{oc} กับ radiation flux	17
2.11 แสดงการสะท้อนกลับของแสง ณ ผิวรอยต่อของฟิล์มกับแผ่นรองรับ	18
2.12 แสดงการสะท้อนและการหักเหของแสง ณ ผิวรอยต่อของฟิล์มกับแผ่นรองรับ	19
2.13 ตัวอย่าง Multi-layer coating	20
2.14 แสดง Moth Eye ในธรรมชาติ	21
2.15 แสดงการสะท้อนและหักเหของแสงที่ผิวรอยต่อของตัวกลาง 2 ตัวกลาง	21
2.16 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์การสะท้อนกับมุมตกกระทบที่ผิว	23
2.17 แสดงโครงสร้างของ ZnO	27
2.18 แสดงความเข้มของแสงก่อนและหลังการทะลุผ่านสาร	28
2.19 แสดงเส้นทางเดินของแสงเมื่อวัดฟิล์มแบบร้อยละการสะท้อน	29
2.20 แสดงส่วนประกอบของสเปกโทรโฟโตมิเตอร์แบบลำรังสีเดี่ยว	31
2.21 แสดงส่วนประกอบของสเปกโทรโฟโตมิเตอร์แบบลำรังสีคู่	32

รูป	หน้า
2.22 แสดงส่วนประกอบของอิลิปโซเมทรี (ellipsometry)	33
2.23 ริงส์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูกปล่อยออกมาโดยแหล่งกำเนิดแสง	34
2.24 แสดงส่วนประกอบของวงรีและค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง	35
2.25 แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ชิ้นงานของ อิลิปโซเมทรี (ellipsometry)	36
2.26 แสดงการสะท้อนและการหักเหของแสงผ่านอากาศ/ฟิล์ม/แผ่นรองรับ	37
2.27 แสดงส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด	39
2.28 แสดงระยะทางที่แสงเดินทางผ่านบรรยากาศ	41
2.29 แสดงมุมตกกระทบ	41
2.30 แสดงการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ที่ AM0 และ AM1.5	42
3.1 แสดงภาพรวมการทดลอง	43
3.2 แสดงลวดสังกะสี (เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.38 mm, ความบริสุทธิ์ 99.97%, Advent Research Materials Ltd)	44
3.3 แสดง Zinc oxide powder มีความบริสุทธิ์ 99.9 %	45
3.4 แสดง Poly ethylene Glycol 20000 (PEG20000)	45
3.5 แสดง Iodine ความบริสุทธิ์ 99.8%	46
3.6 แสดง Lithium iodide anhydrous น้ำหนัก 50 g ประกอบด้วยสัดส่วน purum มากกว่า 98%	46
3.7 แสดง Propylene carbonates	47
3.8 แสดง Eosin -Y ($C_{20}H_6Br_4Na_2O_5$) น้ำหนัก 25 g มีความบริสุทธิ์ 99.99%	47
3.9 แสดง Ethanol ชนิด analytical reagent grade (a) และ standard laboratory grade (b)	48
3.10 แสดง Acetone ชนิด Analytical Reagent grade	48
3.11 แสดง Hydrogen hexachloroplatinate (IV) Hydrate (Cl_6H_2Pt)	49
3.12 แสดงแผ่นพาราฟิล์ม (Parafilm)	49
3.13 แสดงกระจกที่เคลือบด้วยสารนำไฟฟ้า (fluorine-doped tin oxide, FTO)	51
3.14 แสดงเตาเผาสาร (Lenton Furnaces)	51
3.15 แสดงขังสารร้อน Fx 4OCJ	52
3.16 แสดงเครื่องปั่น Hotplate Stirrer รุ่น HTS-100	52

รูป	หน้า
3.17 แสดงไมโครปิเปต รุ่น Rainin	53
3.18 แสดงเครื่องเป่าลมร้อน	53
3.19 แสดงเครื่องอัลตราโซนิก รุ่น Elmasonic	54
3.20 แสดงส่วนประกอบหลักของเครื่องระเหยสารด้วยความร้อน (thermal evaporator)	54
3.21 แสดงส่วนประกอบหลักของเครื่อง sparking process	55
3.22 แสดงเครื่อง UV-visible spectrophotometer รุ่น Carry 50	55
3.23 แสดงเครื่อง อีลิปโซเมทรี (ellipsometry) รุ่น alpha-SE	56
3.24 แสดงส่วนประกอบหลักของชุดทดสอบประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า (J-V tester)	56
3.25 แสดงการระเหยด้วยความร้อนของซิงก์ออกไซด์บนกระจก	58
3.26 แสดงการ sparking ลวดสังกะสีทำให้เกิดอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์บนกระจก	59
3.27 ตัวอย่างที่นำไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องอีลิปโซเมทรี	60
3.28 ตัวอย่างที่นำไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง UV-visible spectrophotometer	61
3.29 แสดงตัวอย่างที่นำไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง FE-SEM	62
3.30 แผนผังการเผาฟิล์ม ZnO	64
3.31 แผนภาพขั้นตอนการเตรียมโฟโตอิเล็กโทโรด	65
3.32 แผนภาพขั้นตอนการเตรียมแคโทดเออร์โรอิเล็กโทโรด	66
3.30 แผนภาพแสดงขั้นตอนการประกอบเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อม	67
4.1 ภาพถ่ายจาก FE-SEM ของฟิล์มบาง ZnO	69
4.2 แสดงสเปกตรัมของสัมประสิทธิ์การส่งผ่านแสงของฟิล์มบาง ZnO ที่เตรียมโดยกระบวนการระเหยด้วยความร้อน และกระบวนการ sparking ที่ 0.5 รอบ 1.5 รอบ และ 2.5 รอบ ของการ sparking	71
4.3 แสดงการประมาณค่าของแถบช่องพลังงานของฟิล์มบาง ZnO	72
4.4 สเปกตรัมของค่าการสะท้อนแสงของ (a) ฟิล์มบาง ZnO ที่เตรียมโดยวิธีการระเหยด้วยความร้อนและวิธีการ sparking ที่ 0.5, 1.5, 2.5 รอบ (b) เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงที่เคลือบด้วยชั้นต่อต้านการสะท้อนแสงฟิล์มบาง ZnO	74

รูป	หน้า
4.5 แสดงแผนภาพการสะท้อนและการหักเหของแสงเมื่อมีฟิล์มชั้นต่อต้านการสะท้อนแสง	76
4.6 แสดงค่าดัชนีหักเหของแสงของฟิล์มบาง ZnO บนแผ่นรองรับที่เป็นกระจกนำไฟฟ้าด้วยเครื่องอิลิปโซเมทรี	76
4.7 แสดงกราฟระหว่างความหนาแน่นกระแสและความศักย์ไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงที่ไม่มีชั้นต่อต้านการสะท้อนแสงและมีชั้นต่อต้านการสะท้อนแสงฟิล์มบาง ZnO	80
4.8 แสดงตัวอย่างวิธีการประมาณค่าหาความต้านทาน R_{sh} และ R_s จากความชันของกราฟ IV ของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง	81